

Title (en)
SEMICONDUCTOR DEVICES WITH PROGRAMMABLE PASSIVE-COMPONENT LAYER AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME.

Title (de)
HALBLEITERANORDNUNGEN MIT PROGRAMMIERBARER SCHICHT MIT PASSIVEN KOMPONENTEN UND DEREN HERSTELLUNGSVERFAHREN.

Title (fr)
DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEURS AVEC COUCHE PROGRAMMABLE AU MOYEN DE COMPOSANTS PASSIFS ET PROCEDE DE PRODUCTION DE TELS DISPOSITIFS.

Publication
EP 0349605 A1 19900110 (EN)

Application
EP 88909595 A 19881111

Priority
GB 8726366 A 19871111

Abstract (en)
[origin: WO8904553A1] A semiconductor wafer or IC array, either analogue or analogue/digital, includes a layer of material which has a substantially linear resistance characteristic and which can be programmed with passive components, i.e. resistors (R) and capacitors (C). The material is preferably polysilicon or chrome disilicide. The passive components (R, C) are configured within the area (10) surrounding active devices (B, P, N) such as CMOS devices and bipolar devices. The process for producing the desired configuration of passive components may include etching of the layer of material.

Abstract (fr)
Un réseau de circuits intégrés ou une tranche de semi-conducteurs, de type analogiques ou analogiques et numériques, comprennent une couche de matériau qui présente une caractéristique de résistance sensiblement linéaire et qui peut être programmée avec des composants passifs, c'est-à-dire des résistances (R) et des condensateurs (C). Le matériau est de préférence à base de polysilicium ou de disiliciure de chrome. Les composants passifs (R, C) sont disposés dans la zone (10) qui entoure les dispositifs actifs (B, P, N), qui sont constitués par exemple par des dispositifs MOS complémentaires et par des dispositifs bipolaires. Le procédé servant à obtenir la disposition désirée des composants passifs peut comporter l'attaque de la couche de matériau.

IPC 1-7
H01L 27/02

IPC 8 full level
H01L 27/04 (2006.01); **H01L 21/70** (2006.01); **H01L 21/768** (2006.01); **H01L 21/82** (2006.01); **H01L 21/822** (2006.01); **H01L 23/525** (2006.01); **H01L 27/118** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01L 21/707 (2013.01); **H01L 21/76886** (2013.01); **H01L 23/525** (2013.01); **H01L 27/11801** (2013.01); **H01L 2924/0002** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 8904553A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 8904553 A1 19890518; AU 2626388 A 19890601; EP 0349605 A1 19900110; GB 2219436 A 19891206; GB 8726366 D0 19871216; GB 8915545 D0 19890823; JP H02502054 A 19900705

DOCDB simple family (application)
GB 8800995 W 19881111; AU 2626388 A 19881111; EP 88909595 A 19881111; GB 8726366 A 19871111; GB 8915545 A 19881111; JP 50886588 A 19881111